文章编号: 1001-3806(2007)06-0627-03

# 小波在基于功率谱密度特征曲线评价中的应用

杨 智,戴一帆\*,王贵林

(国防科学技术大学 机电工程与自动化学院,长沙 410073)

摘要:为了解决功率谱密度仅仅是一种强激光条件下光学元件表面质量评价指标,无法对通过加工来消除某频段 误差进行确定性指导这一问题,采用小波理论对光学元件表面误差进行了分析和试验验证,在利用功率谱密度特征曲线 找到表面误差不合格频率带的基础上,利用二维连续小波变换得到了能作为加工过程反馈的不合格频率带的对应区域。 结果表明,利用此方法能有效地找到特定误差频段对应的区域,从而指导加工,提高加工的效率。

关键词: 光学设计与制造;光学评价;小波;功率谱密度特征曲线 中图分类号: TN 247 文献标识码: A

# The use of wavelet in evaluating optics based on power spectral density character curve

#### YANG Zhi, DAI Yi-fan, WANG Gui-lin

(College of Mechation ics Engineering and Automation, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

**Abstract** In order to solve the problem that power spectral density function (PSD) is only an evaluation guideline to specify large aperture optical components' quality of laser system and can't provide effective guidance for eliminating certain frequency segment error a wavelet method was used to analysis the optical surface errors Firstly, PSD character curve was used to find the unqualified frequency range secondly, two dimensional continuous wavelet transform was used to find the corresponding region of this frequency segment, which can use as feedback to a maturing process. The experiments' results show the use of wavelet can find the corresponding region of certain frequency segment effectively.

Key words optical design and fabrication opper specification wave bet power spectral density character curve

## 引 言

对于强激光条件下大口径光学元件的质量评价, 传统上采用的波前均方根值(not mean square, RMS), 波峰波谷值(peak to valley PV)没泽尼克多项式等指 标因缺乏定量化的波前频谱描述功能,而不能准确完 整的反映强激光系统对光学元件的要求<sup>[1,2]</sup>。美国劳 伦斯利弗莫尔试验室(law rence livem ore national laboratory, LLNL)在研制国家点火装置(national ignition far cility, N IF)的过程中提出了以功率谱密度(power spectral density function, PSD)特征曲线对光学表面进行评 价的新方法<sup>[3~5]</sup>,其主要的思路是通过计算得出光学 元件表面误差的 PSD 曲线,然后将其与 PSD 特征曲线 相比较,当光学元件表面误差的 PSD在特征曲线之下 时是合格的,在特征曲线之上则为不合格,在国内的一

作者简介:杨 智(1978-),男,博士研究生,主要从事微 光机电方面的研究。

\* 通讯联系人。 E-mail dy@ nudt edu cn 收稿日期: 2006-09-15;收到修改稿日期: 2006-11-14 些研究论文中,一般也以此作为判定光学元件表面是 否合格的标准<sup>[1,67]</sup>,国际社会于 1997年颁布光学国 际标准 ISO 10110时, PSD成为了评价光学元件表面质 量的新参数<sup>[8]</sup>。

作为一种评价指标, PSD 是能满足要求的, 然而, 当光学元件利用 PSD 特征曲线检测为不合格时, 无法 知道不合格频带在元件表面发生的区域, 从而不能指 导下一步的加工。因为 PSD 是一种基于傅里叶变换 的处理方法, 是一种全局性的变化。为了将 PSD 特征 曲线与加工更紧密地联系起来, 作者决定在此基础上 采用一种局域性的信号处理方法, 即小波变换。具体 而言, 也就是先利用 PSD 特征曲线找到不合格频带, 然后通过小波变换来得到此不合格频段误差发生的特 定区域, 从而指导加工, 最终减少或消除此频带误差, 提高加工的效率。

#### 1 PSD特征曲线

目前,大体上把制造误差分为 3类:几何形状误 差、表面粗糙度和介于两者之间的表面波纹度,相应的 在频域对应低频、高频和中频。LLNL在研制 N IF 中, 按照具体的空间波长 L 更进一步将其分为<sup>[3]</sup>: (高频 段)L < 0 12mm, 对应 f > 1/L = 8 33mm<sup>-1</sup>; (中频段) 0 12mm  $\leq L \leq$  33mm, 对应 0 03mm<sup>-1</sup>  $\leq f \leq 8$  33mm<sup>-1</sup>; (低频段)L > 33mm, 对应 f < 0.03mm<sup>-1</sup>。

基于此分布, LLNL采用的 PSD 特征曲线为<sup>[5]</sup>:

FSD  $\leq A \cdot f^{-b}$ , 0 03mm<sup>-1</sup>  $\leq f \leq 8$  33mm<sup>-1</sup> (1) 式中, A = 1 05, b = 1. 55, f 为频率, 单位为 mm<sup>-1</sup>, PSD 单 位为 (nm)<sup>2</sup> · mm。当以 log-bg(双对数)曲线描述 (1) 式时, 其为一条具负斜率的直线, 此即 PSD 特征曲线。 在下面的试验中, 以此作为找到不合格频带的依据。

2 试验研究

21 试验原理及步骤

具体而言,试验分为以下几个步骤:(1)用干涉仪 测得一光学元件的表面误差数据;(2)计算得出误差 数据的 PSD 曲线;(3)用 PSD 特征曲线与测得的 PSD 曲线进行比较,找出不合格的频带;(4)针对第 3步得



Fig 1 The surface error and the calculated PSD vs PSD character curve a— the surface error firstly b— the surface error secondly c— the calculat ed PSD vs PSD character curve firstly d— the calculated PSD vs PSD character curve secondly

出的不合格的频带,利用小波方法找出其相对用的空 域分布图,即针对此频带误差的表面区域。

为验证方法的可行性,试验对一块口径 450mm, f/部大镜用 ZYGO干涉仪进行了测量, CCD 阵列有效 像素为 220 × 218,采样周期 2 068mm /pixel 波长为 632 8mm。干涉仪测量结果如图 1a所示。图 1c为测 得的 PSD曲线与 PSD特征曲线的比较 (其中测得的 PSD曲线为 10条采样线的 PSD平均值,且为做快速 傅里叶变换,对实测数据作了补零处理)。

由图 1c可知, 大镜 PSD 曲线有些频率点在 PSD 特征曲线之上, 所以这一大镜是不符合要求的。为简 单起见, 以图 1c中 *f* = 0 03mm<sup>-1</sup>也即中频的起始频率 作为考查频带的中心频率。不难看出, 对于其它不合 格的频带可做类似处理。

考虑到大镜表面为之维面及考察频带的选择任意性,选用二维连续小波变换(continuous wavelet transform 2-D, CW T2D)作为分析工具,一般简记表示为<sup>[9]</sup>:

 $W_f(a, \underline{\theta} \, \overline{b}) = 1/a \cdot \iint \overline{x} \, \psi^* \left[ a^{-1} \overline{r_{\theta}}^1 \left( \overline{x} - \overline{b} \right) \right] d\overline{x}$ (2)

式中 $(x) = [x_1, x_2]^T$ 是平面直角坐标,  $f(\bar{x})$ 表示二维信 劳  $\Psi_f(a, \theta, \bar{b})$ 即表示  $f(\bar{x})$ 的二维连续小波变换,  $\bar{b} =$   $[b_1, b_2]^T$ 分别是  $x_1, x_2$ 方向的位移,  $\bar{x}, \bar{b}$ 表达式中上标 T表示转置, a是尺度因子,  $n_0 = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$ 是坐标 旋转因子,  $\theta$ 为坐标系逆时针旋转角度,  $\Phi[a^{-1}n_0^{-1}(\bar{x} - \bar{b})]$ 表示二维基本小波  $\Phi(\bar{x})$ 的尺度伸缩、坐标旋转及 二维位移, 上标\*表示取共轭。

试验采用 M exican2D 小波, 其表达式为:

 $\Psi(f_{b}, f_{2}) = 2\pi (f_{1}^{2} + f_{2}^{2}) \exp[-(f_{1}^{2} + f_{2}^{2})/2] (3)$ 式中,  $(f_{1}, f_{2})$ 表示频域面坐标。

首先找到与不合格中心频率对应的尺度,由尺度与 频率之间关系<sup>[10]</sup>:  $F_{1} = \frac{F_{c}}{(4)}$ 

$$F_{s} = \frac{F_{c}}{a^{\bullet} \Delta} \tag{4}$$

式中,  $F_c$ 为所采用小波的原始中心频率, a为尺度,  $\Delta$ 为 CCD 阵列采样周期,  $F_s$ 为与尺度相对应频率, 也即 要考察的中心频率。就 M exican2D 小波而言, 参考 MATLAB小波工具箱, 计算得其原始中心频率  $F_c = 0.25 \text{mm}^{-1}$ ,将其与采样周期  $\Delta = 2.068 \text{mm}$  /pixel  $F_s = f = 0.03 \text{mm}^{-1}$  (即开始设定的要考察频带的中心频率  $f = 0.03 \text{mm}^{-1}$ )代入(4)式式得: a = 4.03,因为 M exir can 2D 小波是各向同性的,  $\theta$ 无关紧要( $\theta$ 为(2)式中坐 标系逆时针旋转角度),取  $\theta = 0$ ,利用另一个小波工具 箱对原始误差数据进行二维连续小波变换<sup>[11]</sup>,如图 2 所示(图中标题 fixed表示固定尺度 a = 4.04及  $\theta = 0$ )。





Fig. 2 CW T2D of surface error after the first timemeasure( scale factor a = 4, 03)

#### 2.2 试验结果

可见,针对此频段的对应区域靠近中心固定孔和 边缘,即边缘效应明显。同理,可得到其它不合格频带 的对应区域(从略)。当不合格频带的对应区域找出, 下一步便可指导加工,最终减少或消除此频带误差,提 高加工的效率。针对不同的加工方法,一般就有不同 的局域消除方式,譬如通常的数控抛光,一般可通过适 当选择抛光盘大小及均匀抛光的方式达到局域频带误 差消除的目的,将另文讨论,这里从略。

为比较起见,这儿将同一大镜最终加工后的测量 结果给出,如图 1b所示,图 1d为其 PSD 曲线与特征 曲线的比较,可见,此时大镜是符合要求的。

## 3 结 论

从实际的效果看,利用小波的方法能找到不合格 频带的对应区域,从而为下一步提高加工效率打下基 础。然而有一个问题,即如何考虑干涉仪频率响应特

(上接第 626页)

- [5] ZHAO G, CHEN JG, ZHANG Jet al Analytical description of the damage threshold of fem to second pulses [J]. Laser Technology, 2006 30(1): 90~ 92(in Chinese).
- [6] YOU M, ZHAO W, CHENG G H et al. Crystallization in PTR glass irr duced by irradiation of fem tose cond lasers [J]. Laser Technology 2006 30(1): 41~42(in Chinese).
- [7] LIU Zh, LIR X, YU W et al H eating of planarm etal targets by ultrar short laser pulses [J]. A cta Optic Sinica 2000, 20(10): 1297~1304 (in Chinese).
- [8] CHNE JK, BERAUN JE, GRMESLE et al. Modeling of fem tosec ond laser-induced non-equibrium deformation in metal films [J]. International Journal of Solids and Structures 2002, 39 (12): 3199~ 3216
- [9] CH ICHKOV B N, MOMMA C, NOLTE S et al Fem to sessond picosecond and nanosecond laser ablation of solids [J]. A ppl Phys 1996 A63(2): 109~115

性对真实误差数据的影响。因为干涉仪光学系统的复杂性, 一般的方法是通过试验, 即对一已知样品进行检测进而标定<sup>[3]</sup>, 然而, 高质量的台阶或正弦位相光栅样品难以获得, 同时, 它也不能对测量系统的设计和构建进行有效的指导。基于此考虑, 笔者从原理上对以柯林斯公式描述的光学系统与小波之间的联系进行了 一些探讨, 下一步就希望针对具体的干涉仪进行讨论。

#### 参考文献

- XU Q, GU Y Y, CAIL *et al.* M easurement of wave front power spectral density of large optical components [J]. A eta Optica Sinica, 2001, 21 (3): 344~347(in Chinese).
- [2] YANG H F, JIANG Z F. Research of Zem ke m odal wavefront recorr struction of 19 element H artn ann-Shack wavefront sensor [J]. Laser Techno bgy 2005 29 (5): 484~487(in Chinese).
- [3] LAWSON JK, WOLFE C R, MANES K R et al. Specification of optical components using the power spectral density function [J]. SPIE, 1995, 2536; 38~ 50
- [4] AKENS DM, WOLFECR, LAW SON JK. The use of power spectral density(PSD) functions in specifying optics for the National Ignition Facility [J]. SPIE, 1995, 2536, 281~292
- [5] A KENS D.M. The origin and evolution of the optics for the national ignition facility [J]. SPIE, 1995, 2536; 2~ 12
- [6] REN H, ZHUO Zh Y, JIANG X D et al Discussion of the specific in end of power spectral density [J]. H igh Power Laser and Particle Beams 2002, 14(2): 279~ 282 (in Chinese).
  - XU F, WEIQ Zh, WU F. An alysis about evaluating method of power spectral density function [J]. Optical Instruments 2000, 22(3): 21~24(in Chinese).
- [8] ISO 10110-1997, Optics and optical instrument [S].
- [9] YANG F Sh. The engineering analyses and application of wavelet transform [M]. Beijing Science Press 1999. 1~ 12( in Chinese).
- [10] The Mathworks Inc Wavelet toolbox3 0 1 [EB/OL] http://www. mathworks.com/access/helpdesk/help/pdf\_doc/wavelet/wavelet\_ ug/pdf\_2004-09-13
- [11] The YAW Toolbox Team. Yaw tb-0 1 0 [EB/OL]. http://mlea.tele.ucl.ac.be/yaw.tb/pmw.ik.i.php.M.ain/YAW.Th. 2002-06-15
- [10] AN ISMOV S I, KAPEL DVICH B L, PERELMAN T L. Electron e mission from metal surfaces exposed to ultra short laser pulses [J]. Soviet Physics Journal of Experimental and Theoretical Physics Let ters, 1974, 39 (2): 375~377.
- [11] SHEN ZH, LU JNIXW. Study of the heating mechanism of a Semiconductor imadiated by picosecond and nanosecond laser pulses
  [J]. Chinese Journal of Lasers, 1999, 26(9): 859~863(in Chinese).
- [12] ALIMEN M V. Laser-beam interaction with materials physical principles and applications [M]. Berlin: Springer-Verlag 1987. 201 ~ 207.
- [13] LOU F, JIANG J J SUN C W. Variation in damage thresholds of Si photodiodes with laser pulse duration [J]. High Power Laser and Particle Beams 2004, 16(6): 685~ 688 (in Chinese).
- [14] ELSAYED-ALIH E, NORR B T B, PESSOT M A et al Time-resolved observation of electron-phonon relaxation in copper [J]. Phys R ev L ett 1987, 58 (12): 1212~1215.